スーパークリーンルーム産学官連携研究棟 単価表

2026年10月1日改訂

※ 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当すると判断される場合には、**50%の減額措置**を行います。
※ 処理の内容によっては、単価表に記載された金額よりも高くなる場合もあります。
※ 研究支援施設であるため、大量の試作については受け入れが難しい場合がございます。
詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

● プロセス装置

・スーパークリーンルーム

装置区分	No.	装置番号 ※注1	施設等名称	共用施設等使用料 標準レシピを使用する場合 （円/枚）	共用施設等使用料 チューニングが必要な場合 （円/時間）	共用施設等使用料 同一の標準レシピを使用する場合（～25枚） （円/FOUP）	技術指導費等 ※注2 （円/時間）
露光装置	1	P01-103 P01-102	液浸露光装置用レジスト塗布・現像装置（PRO-Z） ArF液浸露光装置（NSR-S635E）※注3	210,000	630,000	2,625,000	15,000
	2	M01-08 M01-10	KrFレジスト塗布現像装置（CLEAN TRACK ACT 12） KrF露光装置（FPA-5000ES3）※注3 ※注4	48,000	270,000	600,000	15,000
	3	U01-102 U01-101	i線レジスト塗布現像装置（CLEAN TRACK ACT 12） IRアラインメント付i線露光装置（FPA-5510iZs）※注3 ※注4	48,000	270,000	600,000	15,000
塗布現像装置	4	P01-103c	ArF液浸レジスト塗布現像装置(PRO-Z)	60,000	300,000	750,000	15,000
	5	M01-08c	KrFレジスト塗布現像装置（CLEAN TRACK ACT 12）※注4	36,000	180,000	450,000	15,000
	6	U01-102c	i線レジスト塗布現像装置（CLEAN TRACK ACT 12）※注4				
	7	M01-04	レジスト塗布現像装置（CLEAN TRACK ACT 12）				
成膜装置	8	B03-07	プラズマCVD装置（Eagle-12）※注4	42,000	252,000	525,000	15,000
	9	M03-06	プラズマCVD装置（Eagle-12 Rapidfire）※注4				
	10	B03-06	プラズマCVD装置（VECTOR）※注4				
	11	F03-103	プラズマCVD装置（VECTOR）※注4				
	12	M03-01	高密度プラズマCVD装置（Concept 3 Speed）				
	13	P03-101	高密度プラズマCVD装置（MAPLE）※注4				
	14	M03-14	High-k ALD装置（Trias）				
	15	M06-04	メタルCVD装置（Trias-W）				
	16	F03-07	窒化膜LP-CVD装置（TELFORMULA）※注4				
	17	P03-115	窒化膜LP-CVD装置(DJ-1206VN-DF) ※注4				
	18	M03-03	酸化膜LP-CVD(TEOS)装置（TELFORMULA）※注4				
	19	P03-103	Doped-Si LP-CVD装置（DJ1226V-DF）※注4				
	20	U03-101B	プラズマCVD装置（PRODUCER GT Staircase）※注4				
	21	B06-101	バリアシードスパッタ装置（Endura2 EnCoReII Ta/Cu）※注4	60,000	180,000	750,000	15,000
	22	M06-03	メタルスパッタ装置（COSMOS I-1201）	37,000	180,000	462,500	15,000
	23	M06-07	メタルスパッタ装置（ENTRON W-300）※注4				
	24	B06-102	Cuめっき装置（SABRE NExT）	75,000	210,000	937,500	15,000
	25	P06-101	Cuめっき装置（SABRE FX）				
エッチング装置	26	M02-04	Poly-Siエッチング装置（Centura DPSII/axiom）※注4	97,000	270,000	1,212,500	15,000
	27	M02-05	メタルエッチング装置（Centura DPSII/ASPII）※注4				
	28	B02-101	Low-k/メタルエッチング装置（Centura Enabler/DPS232）※注4	60,000	270,000	750,000	15,000
	29	M02-01	酸化膜エッチング装置（Telius SCCM-Ox/DRM-Ox）※注4	30,000	180,000	375,000	15,000
	30	M02-10	酸化膜エッチング装置（Telius DRM-Ox/SCCM-Poly）※注4				
	31	B02-01	Low-kエッチング装置（Telius SCCM-Ox）※注4				
	32	F02-101	新材料エッチング装置（U-8150）※注4				
アッシング装置	33	B02-03	アッシング装置（ICE300/RPA300）※注4	21,000	225,000	262,500	15,000
	34	M02-07	アッシング装置（μASH300）※注4				
	35	P02-105	アッシング装置（ICE300/μASH300）※注4				
イオン注入装置	36	M05-03	高エネルギー中電流イオン注入装置（EXCEED2300V）	103,000	294,000	1,287,500	15,000
	37	F05-101	低エネルギー高電流イオン注入装置（SHX）				
熱処理装置	38	M03-101	RTA/RTP装置（Radiance）※注4	112,000	270,000	1,400,000	15,000
	39	M04-02	ゲート酸窒化RTO/RTP装置（Trias SPA300）	127,000	306,000	1,587,500	15,000
	40	B04-01	縦型アニール装置（VF-5700B）※注4	30,000	240,000	375,000	15,000
	41	M04-101	縦型酸化炉（ALPHA-303i-K）※注4				
洗浄装置	42	M07-15	バッチ式洗浄装置（UW300Z）※注4	27,000	150,000	337,500	15,000
	43	M07-07	酸化膜ウェットエッチング装置（VENUS）※注4				
	44	P07-104	窒化膜ウェットエッチング装置（SFAW-1201-008）※注4				
	45	M07-05	バッチ式スプレー洗浄装置（ZETA300 BE）※注4				
	46	U07-103c	Si裏面研削研磨装置洗浄ユニット（DGP8761SC）				
	47	M07-02	枚葉式洗浄装置（AQUASPIN MP-3000）※注4	11,000	120,000	137,500	15,000
	48	M07-101	枚葉式洗浄装置（AQUASPIN SU-3000）※注4				
	49	M07-102	枚葉式洗浄装置（AQUASPIN SU-3000）※注4				
	50	P07-105	枚葉式洗浄装置（KC-A300CBT）※注4				
	51	M07-13	枚葉式新材料洗浄装置（SEZ323）※注4				
	52	M07-09	スクラブ洗浄装置（AQUASPIN SS-3000）※注4	7,000	60,000	87,500	15,000
	53	M07-12	スクラブ洗浄装置（AQUASPIN SS-3000）※注4				
CMP装置	54	N07-101	STI、W CMP装置（ChaMP-332M A-FP-3000M）	85,000	264,000	1,062,500	15,000
	55	P07-101	Cu CMP装置（F-REX300E）				
	56	U07-101	Oxide CMP装置（Reflexion LK Oxide）				
3D実装装置 （中間工程）	57	B02-101D	Si深掘りエッチング装置（Centura Silvia）※注4	97,000	390,000	1,212,500	15,000
	58	U03-101A	プラズマCVD装置（PRODUCER GT InViaII）※注4	84,000	390,000	1,050,000	15,000
	59	U06-101	Cuめっき装置（NEXX Cu ECD）	150,000	390,000	1,875,000	15,000
	60	U12-102	ウェハ接合装置（WS3000）		390,000		15,000
	61	U07-102	ウェハエッジトリミング装置（DFD6860）※注4	85,000	390,000	1,062,500	15,000
	62	U07-103	Si裏面研削研磨装置（DGP8761SC）	171,000	390,000	2,137,500	15,000

注1～4については2ページ末尾をご参照ください。

● 分析装置

・スーパークリーンルーム

装置区分	No.	装置番号 ※注1	施設等名称	共用施設等使用料 標準レシピを使用する場合 （円/枚）	共用施設等使用料 チューニングが必要な場合 （円/時間）	共用施設等使用料 同一の標準レシピを使用する場合（～25枚） （円/FOUP）	技術指導費等 ※注2 （円/時間）
重ね合わせ精度測定	63	M08-55	重ね合わせ精度測定装置（Archer10-AIM）※注5		171,000		15,000
	64	P08-116	重ね合わせ精度測定装置（Archer10-AIM）※注5				
薄膜解析	65	M08-07	分光エリプソ膜厚測定装置（ASET-F5）※注5		42,000		15,000
	66	M08-101	分光エリプソ膜厚測定装置（ASET-F5X）※注5				
	67	P08-108	分光エリプソ膜厚測定装置（μSE-2500-A）※注5				
	68	I08-101	分光エリプソ膜厚測定装置（M-2000X）※注5				
	69	P08-104	反射分光膜厚測定装置（F50-EXR）※注5				
	70	M12-08	蛍光X線膜厚測定装置（System 3272E）※注5		60,000		15,000
	71	P12-104	蛍光X線膜厚測定装置（2830ZT）※注5				
	72	F08-04	X線回折装置（TTR In-plane XRD）※注5		84,000		15,000
反り・応力測定	73	B12-101	反り/膜応力自動測定装置（128LC2C）※注5		36,000		15,000
	74	M08-12	反り/膜応力測定装置（128L）※注5				
パーティクル検査	75	P08-105	パーティクル検査装置（WM-10）※注5		84,000		15,000
	76	P08-106	パーティクル検査装置（WM-10）※注5				
金属汚染検査	77	P08-107	全反射蛍光X線分析装置（TXRF 310Fab）※注5		60,000		15,000
	78	P08-109 P08-113	自動濃縮装置（Expert） ICP-MS質量分析装置（NexION 2000） ※注3 ※注5				
抵抗測定	79	M08-10	シート抵抗測定装置（RS-100）※注5		18,000		15,000
	80	P08-102	シート抵抗測定装置（VR300DSE）※注5				
	81	P08-120	シート抵抗測定装置（VR300DH1）※注5				
SEM観察	82	I08-110	測長SEM装置（CG5000）※注5		45,000		15,000
	83	L08-103	測長SEM装置（CG4000）※注5				
	84	P08-101	測長SEM装置（S-9380Ⅱ）※注5				
	85	P08-103	測長SEM装置（S-9380Ⅱ）※注5				
	86	P08-115	レビューSEM（SEMVision G6）※注5		162,000		15,000
光学顕微鏡	87	M08-40	光学顕微鏡（AL3110F）※注5		6,000		15,000
	88	M08-50	光学顕微鏡（AL3110F）※注5				
	89	M12-101	光学顕微鏡（AL110）※注5				
	90	M12-102	光学顕微鏡（AL120）※注5				
3D実装評価装置	91	P08-110	超音波顕微鏡（FastLine P300）※注5		36,000		15,000
	92	P08-111	高精度微細形状測定機（ET4000L）※注5		15,000		15,000
	93	P08-112	赤外線顕微鏡システム（DSI-300SA-IR）※注5				
	94	P08-114	赤外線拡大鏡（BL-3000A）※注5		6,000		15,000

・スーパークリーンルーム外

FIB加工/STEM	95	B08-02-01 AF08-402	FIB装置（FB2100） 走査透過電子顕微鏡（HD-2700）※注3 ※注5		36,000		15,000
断面SEM	96	J03-117	走査電子顕微鏡（S-4700）※注5		15,000		15,000
	97	M08-04	走査電子顕微鏡（S-5000）※注5				
	98	B08-12	走査電子顕微鏡（S-5200）※注5				
	99	J04-108	走査電子顕微鏡（SU9000II）※注5		24,000		15,000
電気特性評価	100	J03-118	フルオートプローバ（P-12XL） テスター（4073B/N9201A）		57,000		15,000
	101	M08-42 M10-01	フルオートプローバ（P-12XL） テスター （4073A）※注3				
	102	M10-05	フルオートプローバ（P-12XL） テスター（4076）				
	103	J03-126	セミオートプローバ（CM300xi）				
	104	J03-113	セミオートプローバ（S-300）				
分析	105	AF08-14	X線光電子分光分析装置（ESCA-1800）		60,000		15,000

注1　装置番号は、SCRで装置管理のために使用している番号です。
注2　技術指導費等は、装置使用方法の指導、あるいは特別な作業依頼の場合に、利用者と協議の上で適用いたします。
注3　これらの装置はセットでのご利用となります。
注4　利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当し、かつ、操作方法習得済の利用者自身による夜間等流動の場合、FOUP単位料金の50%減額を行います。
注5　プロセス装置をご利用になられる方のみに利用提供している装置です。

利用料等についての補足
◇追加料金：追加的に必要な作業等が発生した場合に以下に記載の料金を徴収させていただきます。（共用施設等利用約款（第6条第1項第5号））
　ア　改造費：共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額。
　イ　復元費：改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額。
　ウ　その他実費：共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の役務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額。
　　SCRでは300mmウェハ在庫品の提供に際して、以下の料金を徴収しています。この金額は単価表改訂時のものであり、市場価格の変動により予告なく変更する場合があります。
　　・ウェハ（プロセスダミーグレード、リソグレード、通常在庫有）：20,000円/枚
◇運営管理費：利用料金（共用施設等使用料、技術指導費等、追加料金の合計）額に15パーセントを乗じた額を運営管理費として加算させていただきます。（約款第6条第1項第6号）
◇消費税：利用料金と運営管理費の合計額に消費税が加算されます。消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てで処理いたします。